



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

مدلسازی فشرده و اثرات اتصال در ترانزیستورهای لایه نازک

عنوان انگلیسی مقاله :

Compact Modeling and Contact Effects in Thin Film Transistors



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



## بخشی از ترجمه مقاله

### IX. CONCLUSION

By carefully inspecting past and current achievements in modeling the contact effects of OTFTs, we have proposed a model for the current-voltage curves at the contact region that unifies different trends found in experimental data. This model, which is characterized by only one parameter, has been embedded in a generic charge drift model that also includes a gate voltage-dependent mobility. The model is easily reduced to the generic FET model with a constant mobility and no contact effects.

#### 9. نتیجه گیری

ما با بررسی دقیق دستیابی های گذشته و حال در مدلسازی اثرات اتصال ترانزیستورهای OTFT مدلی را برای منحنی های ولتاژ- جریان در ناحیه اتصال ارائه داده ایم که روندهای مختلف دیده شده در داده های آزمایشی را با هم تلفیق می سازد. این مدل که مشخصه آن تنها یک پارامتر می باشد، در یک مدل بار کلی گنجانده شده است که دربرگیرنده یک تحرک گیت وابسته به ولتاژ نیز می باشد و براحتی به مدل کلی ترانزیستور FET با یک تحرک ثابت و بدون آثار اتصال قابل کاهش دادن می باشد.



### توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.